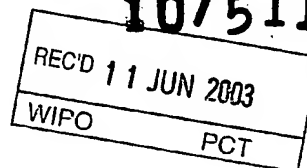


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PCT/DE 03/01216

Rec'd PCT/PTO 15 OCT 2004

10/511389



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 16 671.4

Anmeldetag: 15. April 2002

Anmelder/Inhaber: Applied Films GmbH & Co KG, Alzenau/DE

Bezeichnung: Beschichtungsanlage

IPC: C 23 C 14/34

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 27. Mai 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Hiebinger

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

A 9161
06/00
EDV-L

BEST AVAILABLE COPY



Beschreibung

Beschichtungsanlage

Die Erfindung betrifft eine Beschichtungsanlage mit einem eine Absaugung und eine Gaszuführung aufweisenden Rezipienten, in welchem eine Zerstäuber-kathode und ein Substrathalter untergebracht sind und bei der der Rezipient durch eine zwischen der Zerstäuber-kathode und dem Substrathalter angeordnete Blende in einen Kathodenraum und einen Substratraum unterteilt ist.

Eine Beschichtungsanlage der vorstehenden Art ist Gegenstand der EP 0 795 623. Bei der in dieser Schrift gezeigten Beschichtungsanlage strömt aus Argon und Sauerstoff bestehendes Prozessgas nahe des Substrates in den Substratraum und wird oberhalb der Blende über eine Absaugung am Kathodenraum abgeführt. Eine als Lambda-Sonde ausgeführte Messeinrichtung im Kathodenraum dient dazu, den Sauerstoffgehalt im Kathodenraum zu überwachen und nach dem Sauerstoffgehalt die Leistung der Zerstäuber-kathode zu steuern. Durch die gemeinsame Zuführung des Reaktivgases und des Prozessgases und durch die Abführung des Gases über eine Absaugung am Kathodenraum lässt sich nicht vermeiden, dass das Target der Zerstäuber-kathode einer beträchtlichen Sauerstoffkonzentration ausgesetzt ist. Dadurch kommt es zu einer unerwünschten Oxidation des Targets, wodurch sich anstelle einer erwünschten hohen metallischen Oxidationsrate eine niedrige oxidische Oxidationsrate ergibt. Die Blende gemäß der EP 0 795 623 hat den Sinn, eine Minderung der Schichtqualität durch Schrägbeschichtung zu unterbinden.

- 2 -

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Beschichtungsanlage der eingangs genannten Art so zu gestalten, dass eine ausreichend hohe Konzentration von Reaktivgas möglich ist, um eine vollständige Reaktion der sich bildenden Schicht zu ermöglichen, ohne dass dadurch zugleich die Targetoberfläche in unerwünschter Weise mit dem Reaktivgas reagiert und es dadurch zu einer Leistungsverminderung der Beschichtungsanlage kommt.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass sowohl der Kathodenraum als auch der Substratraum eine unmittelbare Absaugung und jeweils eine eigene Gaszuführung aufweisen und dass die Gaszuführung in den Kathodenraum mit einer Prozessgasquelle und die Gaszuführung für den Substratraum mit einer Reaktivgasquelle Verbindung hat.

Durch diese Gestaltung der Beschichtungsanlage kommt es zu weitgehend unabhängigen Gasströmungen in dem Kathodenraum und dem Substratraum. Das Reaktivgas wird erfindungsgemäß durch die Blende vom Sputtervorgang abgeschirmt. Dadurch gelangen nur noch unbedeutende Mengen des Reaktivgases - im Regelfall Sauerstoff - in den Kathodenraum, so dass es zu keiner Reaktion der Targetoberfläche und damit einer Verringerung der Beschichtungsleistung der Beschichtungsanlage kommt. Der Fluss der die Schicht bildenden, von der Targetoberfläche stammenden Teilchen gelangt durch die Öffnung der Blende hindurch zum Substrat. Dank der erfindungsgemäßen Ausbildung von zwei separaten Gasströmungen im Rezipienten kann die Öffnung in der Blende groß sein, so dass die von der Targetoberfläche stammenden Teilchen auf dem Weg zum Substrat wenig behindert werden, ohne dass umgekehrt unerwünscht viel Sauerstoff die Zerstäubungskathode erreicht und es dort zu einer Oxidation kommt. Es zeigte sich, dass die Abblendwirkung der Blende für die gesputterten Teilchen

sich durch die mögliche Ratenerhöhung am Target aufgrund des dort geringeren Reaktivgasanteils überkompensieren lässt. Besonders deutliche Steigerungen der spezifischen Beschichtungsleistung ergaben sich mit der erfindungsgemäßen Beschichtungsanlage bei der Erzeugung von transparenten SnO- und ZnO-Schichten mit reaktiv betriebenen DC-Zerstäuber-kathoden.

Eine besonders gute Trennung der Gasströme ergibt sich, wenn der Kathodenraum und der Substratraum jeweils mit einem eigenen Unterdruckpumpstand verbunden sind.

Zur weiteren Trennung der beiden Gasströme trägt es bei, wenn sowohl im Kathodenraum als auch im Substratraum die Gaszuführung und die Absaugung an gegenüberliegenden Seiten angeordnet sind.

Zur weiteren Verbesserung der Schichtqualität trägt es bei, wenn im Rezipienten zwischen der Zerstäuber-kathode und dem Substrat eine Anode angeordnet ist.

Der Einfluss des Plasmaglows auf das Schichtwachstum wird möglichst wenig gehemmt, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung die Anode im Substratraum von der Blende abgedeckt zwischen der Blende und dem Substrathalter angeordnet ist. Eine solche Anode bewirkt, dass sich der Plasmaglow durch die Blendenöffnung hindurch über die Beschichtungsstelle des Substrates hinweg in Richtung der Schlitzschleuse erstreckt. Hierdurch lassen sich auch die Schichteigenschaften verbessern. Insbesondere ist durch eine solche Anodenanordnung eine hohe Schichtdicke zu erreichen. Da die Anode von der Blende abgedeckt ist, kommt es zu keiner nennenswerten Beschichtung der Anode.

Die Anode kann auf übliche Weise ausgebildet sein. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Anode durch zwei unbe-

- 4 -

heizte Rohre gebildet ist. Da SnO und ZnO eine relativ hohe Leitfähigkeit besitzen, spielt die während des Beschichtungsvorganges des Substrates zwangsläufig erfolgende Beschichtung der Anode und ihr damit eintretender Wirkungsverlust bei solchen Beschichtungsmaterialien keine Rolle. Es kann jedoch auch vorgesehen werden, die Anode, umgeben mit einem schwachen Magnetfeld, pulsweise auf negatives Potential zu setzen, um sie leitfähig und sauber zu halten.

Möglich ist es jedoch auch vorzusehen, dass die Anode zugleich die Blende bildet.

Der weiteren Leistungssteigerung der Beschichtungsanlage dient es, wenn die Kathode eine Doppel-Magnetronkathode ist.

Das Target wird möglichst gleichmäßig abgetragen und hat deshalb eine möglichst lange Lebensdauer, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung die Kathode eine Rotationskathode ist.

Oxidische und damit geringe Erosionsraten des Targets lassen sich zuverlässig vermeiden, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung im Kathodenraum eine Messeinrichtung für Reaktivgas angeordnet ist und die Beschichtungsanlage eine Leistungsregelung der Zerstäuberkathode in Abhängigkeit von der Konzentration des Reaktivgases in dem Kathodenraum aufweist.

Als besonders vorteilhaft hat sich herausgestellt, wenn das Verhältnis der in Transportrichtung des Substrates gemessenen Blendenöffnungsgröße der Blende zur in Transportrichtung des Substrates gemessenen Breite der Zerstäuberkathode weniger als 0,75, vorzugsweise 0,5 bis 0,3 beträgt.

...

Die Erfindung lässt verschiedene Ausführungsformen zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips ist eine davon schematisch in der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben.

Die Zeichnung zeigt im Schnitt eine erfindungsgemäße Beschichtungsanlage. Diese hat einen Rezipienten 1, der durch eine Blende 2 in einen Kathodenraum 3 und einen Substratraum 4 unterteilt ist. Im Kathodenraum 3 befindet sich eine elektrisch gegenüber dem Rezipienten 1 isolierte Zerstäuber-kathode 5, die bei diesem Ausführungsbeispiel als Magnetronkathode ausgebildet ist und an der Seite der Blende 2 ein Target 6 aufweist. Unterhalb der Blende 2 und von dieser abgedeckt ist im Substratraum 4 eine Anode 7 angeordnet. In der Zeichnung gesehen an der linken Seite des Kathodenraumes 3 befindet sich eine Gaszuführung 8, die mit einer Prozessgasquelle 9 verbunden ist. An der gegenüberliegenden Seite des Kathodenraumes 3 ist eine Absaugung 10 mit einem Unterdruckpumpstand 11 angeordnet.

Im Substratraum 4 befindet sich ein Substrathalter 12 mit einem zu beschichtenden Substrat 13. Das Verhältnis der in Transportrichtung des Substrates 13 gemessenen Blendenöffnungs-länge der Blende 2 zur in Transportrichtung des Substrates 13 gemessenen Breite der Zerstäuber-kathode 5 beträgt weniger als 0,75, vorzugsweise 0,5 bis 0,3. Genau wie der Kathodenraum 3 hat der Substratraum 4 an der gleichen Seite wie der Kathodenraum 3 eine Gaszuführung 14, die mit einer Reaktivgasquelle 15 Verbindung hat. Weiterhin ist der Gaszuführung 14 gegenüberliegend eine Absaugung 16 mit einem Unterdruckpumpstand 17 vorgesehen.

Zur Regelung des Beschichtungsvorganges ist in dem Kathodenraum 3 eine als Lambdasonde ausgebildete Messeinrich-

...

- 6 -

tung 18 mit einer Sondenheizung 20 angeordnet, welche mit einer Leistungsregelung 19 der Zerstäuber Kathode 5 Verbindung hat. Dadurch wird die Konzentration des Reaktivgases in dem Kathodenraum 3 - im Regelfall die Sauerstoffkonzentration - gemessen und danach die Spannung der Zerstäuber Kathode 5 geregelt.

Bezugszeichenliste

- 1 Rezipient
- 2 Blende
- 3 Kathodenraum
- 4 Substratraum
- 5 Zerstäuber Kathode
- 6 Target
- 7 Anode
- 8 Gaszuführung
- 9 Prozessgasquelle
- 10 Absaugung
- 11 Unterdruckpumpstand
- 12 Substrathalter
- 13 Substrat
- 14 Gaszuführung
- 15 Reaktivgasquelle
- 16 Absaugung
- 17 Unterdruckpumpstand
- 18 Messeinrichtung
- 19 Leistungsregelung
- 20 Sondenheizung

Patentansprüche

1. Beschichtungsanlage mit einem eine Absaugung und eine Gaszuführung aufweisenden Rezipienten (1), in welchem eine Zerstäuber Kathode (5) und ein Substrathalter (12) untergebracht sind und bei der der Rezipient (1) durch eine zwischen der Zerstäuber Kathode (5) und dem Substrathalter (12) angeordnete Blende (2) in einen Kathodenraum (3) und einen Substratraum (4) unterteilt ist, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der Kathodenraum (3) als auch der Substratraum (4) eine unmittelbare Absaugung (10, 16) und jeweils eine eigene Gaszuführung (8, 14) aufweisen und dass die Gaszuführung (8) in den Kathodenraum (3) mit einer Prozessgasquelle (9) und die Gaszuführung (14) für den Substratraum (4) mit einer Reaktivgasquelle (15) Verbindung hat.
2. Beschichtungsanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kathodenraum (3) und der Substratraum (4) jeweils mit einem eigenen Unterdruckpumpstand (11, 17) verbunden sind.
3. Beschichtungsanlage nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl im Kathodenraum (3), als auch im Substratraum (4) die Gaszuführung (8, 14) und die Absaugung (10, 16) an gegenüberliegenden Seiten angeordnet sind.
4. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Rezipienten (1) zwischen der Zerstäuber Kathode (5) und dem Substrat (13) eine Anode (7) angeordnet ist.
5. Beschichtungsanlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Anode (7) im Substratraum (4) von der

- 9 -

Blende (2) abgedeckt zwischen der Blende (2) und dem Substrathalter (12) angeordnet ist.

6. Beschichtungsanlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Anode (7) durch zwei unbeheizte Rohre gebildet ist.

7. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anode (7) zugleich die Blende (2) bildet.

8. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zerstäuber-kathode (5) eine Doppel-Magnetronkathode ist.

9. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zerstäuber-kathode (5) eine Rotationskathode ist.

10. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Kathodenraum (3) eine Messeinrichtung (18) für Reaktivgas angeordnet ist und die Beschichtungsanlage eine Leistungsregelung (19) der Zerstäuber-kathode (5) in Abhängigkeit von der Konzentration des Reaktivgases in dem Kathodenraum (3) aufweist.

11. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der in Transportrichtung des Substrates (13) gemessenen Blendenöffnungs-länge der Blende (2) zur in Transportrichtung des Substrates (13) gemessenen Breite der Zerstäuber-kathode (5) weniger als 0,75, vorzugsweise 0,5 bis 0,3 beträgt.

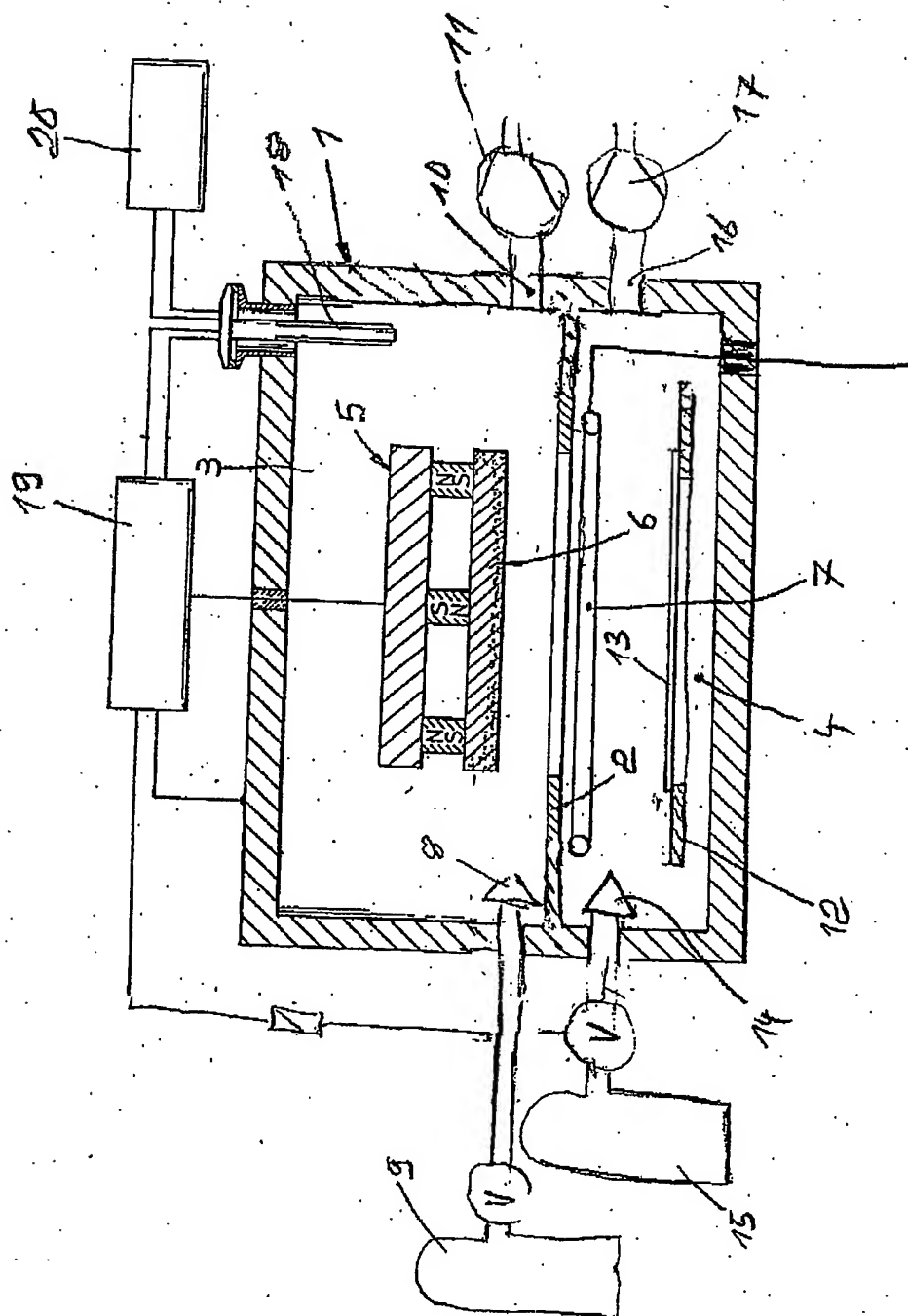
- 10 -

Zusammenfassung

Beschichtungsanlage

Bei einer Beschichtungsanlage ist ein Rezipient (1) durch eine Blende (2) in einen Kathodenraum (3) und einen Substratraum (4) unterteilt. Sowohl der Kathodenraum (3) als auch der Substratraum (4) weisen eine unmittelbare Absaugung (10, 16) und jeweils eine eigene Gaszuführung (8, 14) auf. Die Gaszuführung (8) in den Kathodenraum (3) ist mit einer Prozessgasquelle (9) und die Gaszuführung (14) für den Substratraum (4) mit einer Reaktivgasquelle (15) verbunden.

(einzige Figur)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/L 03/01216

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 IPC 7 C23C14/00 H01J37/34

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 IPC 7 C23C H01J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 908 531 A (CANON KK) 14 April 1999 (1999-04-14)	1,3,4,6, 7,11
Y	paragraphs '0033!-'0035!,'0041!,'0042!; figure 2	5,8-10
X	EP 0 860 513 A (CANON KK) 26 August 1998 (1998-08-26) column 16, line 52 -column 18, line 14; figure 9	1,2,4,6, 7,11
Y	US 4 392 939 A (CROMBEEN JACOBUS E ET AL) 12 July 1983 (1983-07-12) column 2, line 60 -column 3, line 19; figure 1	5
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 December 2003

Date of mailing of the international search report

17/12/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hoyer, W

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/DE 03/01216

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 5 427 665 A (HARTIG KLAUS ET AL) 27 June 1995 (1995-06-27) column 3, line 53 -column 4, line 51; claims 1,6,8; figures 2-4 -----	8,9
Y	EP 0 701 270 A (BOC GROUP INC) 13 March 1996 (1996-03-13) column 3, line 40 -column 4, line 50; figure 1 -----	8,9
Y	EP 0 795 623 A (LEYBOLD SYSTEMS GMBH) 17 September 1997 (1997-09-17) column 2, line 57 -column 3, line 45; figures 1-3 -----	10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/JP 03/01216

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0908531	A	14-04-1999	EP 0908531 A2	14-04-1999
			JP 11172430 A	29-06-1999
			US 6238527 B1	29-05-2001
EP 0860513	A	26-08-1998	EP 0860513 A2	26-08-1998
			EP 0860514 A2	26-08-1998
			JP 3332839 B2	07-10-2002
			JP 11001771 A	06-01-1999
			JP 3332840 B2	07-10-2002
			JP 10298753 A	10-11-1998
			US 6451184 B1	17-09-2002
			US 6200431 B1	13-03-2001
US 4392939	A	12-07-1983	NL 8200902 A	03-10-1983
			AT 22752 T	15-10-1986
			AU 560381 B2	02-04-1987
			AU 1203283 A	08-09-1983
			CA 1192318 A1	20-08-1985
			DE 3366772 D1	13-11-1986
			EP 0088463 A1	14-09-1983
			ES 8401678 A1	01-03-1984
			JP 1591463 C	30-11-1990
			JP 2014425 B	09-04-1990
			JP 58164783 A	29-09-1983
US 5427665	A	27-06-1995	DE 4025231 A1	16-01-1992
			DE 4038577 A1	11-06-1992
EP 0701270	A	13-03-1996	AU 2857595 A	21-03-1996
			CA 2156350 A1	07-03-1996
			CN 1126365 A	10-07-1996
			DE 69508011 D1	08-04-1999
			DE 69508011 T2	15-07-1999
			EP 0701270 A1	13-03-1996
			JP 8170172 A	02-07-1996
			SG 32468 A1	13-08-1996
			US 5645699 A	08-07-1997
			ZA 9506811 A	14-05-1996
EP 0795623	A	17-09-1997	DE 19609970 A1	18-09-1997
			DE 59609093 D1	23-05-2002
			EP 0795623 A1	17-09-1997
			ES 2173243 T3	16-10-2002
			JP 10008247 A	13-01-1998
			KR 269006 B1	16-10-2000
			TW 419527 B	21-01-2001
			US 2002157945 A1	31-10-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EE 03/01216

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C23C14/00 H01J37/34

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 C23C H01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 908 531 A (CANON KK) 14. April 1999 (1999-04-14)	1,3,4,6, 7,11
Y	Absätze '0033!-'0035!,'0041!,'0042!; Abbildung 2	5,8-10
X	EP 0 860 513 A (CANON KK) 26. August 1998 (1998-08-26) Spalte 16, Zeile 52 -Spalte 18, Zeile 14; Abbildung 9	1,2,4,6, 7,11
Y	US 4 392 939 A (CROMBEEN JACOBUS E ET AL) 12. Juli 1983 (1983-07-12) Spalte 2, Zeile 60 -Spalte 3, Zeile 19; Abbildung 1	5
	--- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

8. Dezember 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

17/12/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hoyer, W

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
Y	US 5 427 665 A (HARTIG KLAUS ET AL) 27. Juni 1995 (1995-06-27) Spalte 3, Zeile 53 -Spalte 4, Zeile 51; Ansprüche 1,6,8; Abbildungen 2-4 ----	8,9
Y	EP 0 701 270 A (BOC GROUP INC) 13. März 1996 (1996-03-13) Spalte 3, Zeile 40 -Spalte 4, Zeile 50; Abbildung 1 ----	8,9
Y	EP 0 795 623 A (LEYBOLD SYSTEMS GMBH) 17. September 1997 (1997-09-17) Spalte 2, Zeile 57 -Spalte 3, Zeile 45; Abbildungen 1-3 -----	10

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0908531 A	14-04-1999	EP 0908531 A2 JP 11172430 A US 6238527 B1	14-04-1999 29-06-1999 29-05-2001
EP 0860513 A	26-08-1998	EP 0860513 A2 EP 0860514 A2 JP 3332839 B2 JP 11001771 A JP 3332840 B2 JP 10298753 A US 6451184 B1 US 6200431 B1	26-08-1998 26-08-1998 07-10-2002 06-01-1999 07-10-2002 10-11-1998 17-09-2002 13-03-2001
US 4392939 A	12-07-1983	NL 8200902 A AT 22752 T AU 560381 B2 AU 1203283 A CA 1192318 A1 DE 3366772 D1 EP 0088463 A1 ES 8401678 A1 JP 1591463 C JP 2014425 B JP 58164783 A	03-10-1983 15-10-1986 02-04-1987 08-09-1983 20-08-1985 13-11-1986 14-09-1983 01-03-1984 30-11-1990 09-04-1990 29-09-1983
US 5427665 A	27-06-1995	DE 4025231 A1 DE 4038577 A1	16-01-1992 11-06-1992
EP 0701270 A	13-03-1996	AU 2857595 A CA 2156350 A1 CN 1126365 A DE 69508011 D1 DE 69508011 T2 EP 0701270 A1 JP 8170172 A SG 32468 A1 US 5645699 A ZA 9506811 A	21-03-1996 07-03-1996 10-07-1996 08-04-1999 15-07-1999 13-03-1996 02-07-1996 13-08-1996 08-07-1997 14-05-1996
EP 0795623 A	17-09-1997	DE 19609970 A1 DE 59609093 D1 EP 0795623 A1 ES 2173243 T3 JP 10008247 A KR 269006 B1 TW 419527 B US 2002157945 A1	18-09-1997 23-05-2002 17-09-1997 16-10-2002 13-01-1998 16-10-2000 21-01-2001 31-10-2002

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.